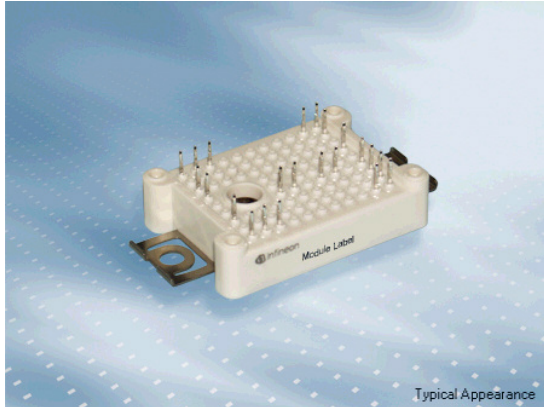
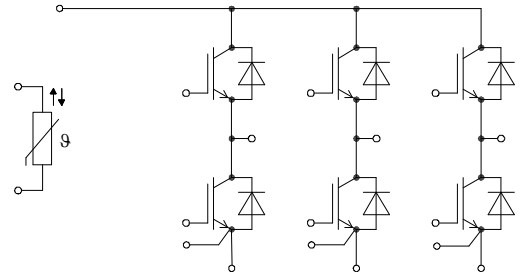


EasyPACK Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode und PressFIT / NTC  
EasyPACK module with Trench/Fieldstop IGBT3 and Emitter Controlled 3 diode and PressFIT / NTC



Typical Appearance



$V_{CES} = 650V$   
 $I_{C\ nom} = 50A / I_{CRM} = 100A$

**Typische Anwendungen**

- Hybrid-Elektrofahrzeuge (H)EV
- Klimaanlage
- Motorantriebe

**Typical Applications**

- Hybrid Electrical Vehicles (H)EV
- Air Conditioning
- Motor Drives

**Elektrische Eigenschaften**

- Erhöhte Sperrspannungsfestigkeit auf 650V
- Niedrige Schaltverluste
- Niedriges  $V_{CEsat}$
- Trench IGBT 3

**Electrical Features**

- Increased blocking voltage capability to 650V
- Low Switching Losses
- Low  $V_{CEsat}$
- Trench IGBT 3

**Mechanische Eigenschaften**

- $Al_2O_3$  Substrat mit kleinem thermischen Widerstand
- Hohe Leistungsdichte
- Integrierter NTC Temperatur Sensor
- Kompaktes Design
- PressFIT Verbindungstechnik
- RoHS konform
- Robuste Montage durch integrierte Befestigungsklammern

**Mechanical Features**

- $Al_2O_3$  Substrate with Low Thermal Resistance
- High Power Density
- Integrated NTC temperature sensor
- Compact design
- PressFIT Contact Technology
- RoHS compliant
- Rugged mounting due to integrated mounting clamps

**Module Label Code**

Barcode Code 128



DMX - Code



**Content of the Code**

| Content of the Code        | Digit   |
|----------------------------|---------|
| Module Serial Number       | 1 - 5   |
| Module Material Number     | 6 - 11  |
| Production Order Number    | 12 - 19 |
| Datecode (Production Year) | 20 - 21 |
| Datecode (Production Week) | 22 - 23 |

|                 |                                 |                    |
|-----------------|---------------------------------|--------------------|
| prepared by: SS | date of publication: 2012-01-12 | material no: 35374 |
| approved by: TR | revision: 3.0                   |                    |

**IGBT-Wechselrichter / IGBT-inverter**

**Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values**

|  |  |                       |          |        |
|--|--|-----------------------|----------|--------|
| Kollektor-Emitter-Sperrspannung<br>Collector-emitter voltage             | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$  | $V_{CES}$             | 650      | V      |
| Kollektor-Dauergleichstrom<br>Continuous DC collector current            | $T_C = 90^{\circ}\text{C}, T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$<br>$T_C = 25^{\circ}\text{C}, T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$ | $I_{C\ nom}$<br>$I_C$ | 50<br>70 | A<br>A |
| Periodischer Kollektor-Spitzenstrom<br>Repetitive peak collector current | $t_p = 1\ \text{ms}$   | $I_{CRM}$             | 100      | A      |
| Gesamt-Verlustleistung<br>Total power dissipation                        | $T_C = 25^{\circ}\text{C}, T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$   | $P_{tot}$             | 205      | W      |
| Gate-Emitter-Spitzenspannung<br>Gate-emitter peak voltage                |  | $V_{GES}$             | +/-20    | V      |

**Charakteristische Werte / Characteristic Values**

|   |   |   | min.          | typ.                    | max. |             |   |
|---|---|---|---------------|-------------------------|------|-------------|---|
| Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung<br>Collector-emitter saturation voltage    | $I_C = 50\ \text{A}, V_{GE} = 15\ \text{V}$<br>$I_C = 50\ \text{A}, V_{GE} = 15\ \text{V}$<br>$I_C = 50\ \text{A}, V_{GE} = 15\ \text{V}$   | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$                 | $V_{CE\ sat}$ | 1,45<br>1,60<br>1,70    | 1,90 | V<br>V<br>V |   |
| Gate-Schwellenspannung<br>Gate threshold voltage                                | $I_C = 0,80\ \text{mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$   |   | $V_{GEth}$    | 4,9                     | 5,8  | 6,5         | V   |
| Gateladung<br>Gate charge   | $V_{GE} = -15\ \text{V} \dots +15\ \text{V}$  |   | $Q_G$         | 0,50                    |      |             | $\mu\text{C}$                                   |
| Interner Gatewiderstand<br>Internal gate resistor                               | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$   |   | $R_{Gint}$    | 0,0                     |      |             | $\Omega$  |
| Eingangskapazität<br>Input capacitance  | $f = 1\ \text{MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\ \text{V}, V_{GE} = 0\ \text{V}$   |   | $C_{ies}$     | 3,10                    |      |             | nF  |
| Rückwirkungskapazität<br>Reverse transfer capacitance                           | $f = 1\ \text{MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\ \text{V}, V_{GE} = 0\ \text{V}$   |   | $C_{res}$     | 0,095                   |      |             | nF  |
| Kollektor-Emitter-Reststrom<br>Collector-emitter cut-off current                | $V_{CE} = 650\ \text{V}, V_{GE} = 0\ \text{V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$   |   | $I_{CES}$     |                         |      | 0,05        | mA  |
| Gate-Emitter-Reststrom<br>Gate-emitter leakage current                          | $V_{CE} = 0\ \text{V}, V_{GE} = 20\ \text{V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$  |   | $I_{GES}$     |                         |      | 400         | nA  |
| Einschaltverzögerungszeit, induktive Last<br>Turn-on delay time, inductive load | $I_C = 50\ \text{A}, V_{CE} = 300\ \text{V}$<br>$V_{GE} = \pm 15\ \text{V}$<br>$R_{Gon} = 6,8\ \Omega$  | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$                 | $t_{d\ on}$   | 0,023<br>0,023<br>0,023 |      |             | $\mu\text{s}$<br>$\mu\text{s}$<br>$\mu\text{s}$ |
| Anstiegszeit, induktive Last<br>Rise time, inductive load                       | $I_C = 50\ \text{A}, V_{CE} = 300\ \text{V}$<br>$V_{GE} = \pm 15\ \text{V}$<br>$R_{Gon} = 6,8\ \Omega$  | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$                 | $t_r$         | 0,019<br>0,022<br>0,022 |      |             | $\mu\text{s}$<br>$\mu\text{s}$<br>$\mu\text{s}$ |
| Abschaltverzögerungszeit, induktive Last<br>Turn-off delay time, inductive load | $I_C = 50\ \text{A}, V_{CE} = 300\ \text{V}$<br>$V_{GE} = \pm 15\ \text{V}$<br>$R_{Goff} = 6,8\ \Omega$   | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$                 | $t_{d\ off}$  | 0,17<br>0,19<br>0,20    |      |             | $\mu\text{s}$<br>$\mu\text{s}$<br>$\mu\text{s}$ |
| Fallzeit, induktive Last<br>Fall time, inductive load                           | $I_C = 50\ \text{A}, V_{CE} = 300\ \text{V}$<br>$V_{GE} = \pm 15\ \text{V}$<br>$R_{Goff} = 6,8\ \Omega$   | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$                 | $t_f$         | 0,03<br>0,04<br>0,05    |      |             | $\mu\text{s}$<br>$\mu\text{s}$<br>$\mu\text{s}$ |
| Einschaltverlustenergie pro Puls<br>Turn-on energy loss per pulse               | $I_C = 50\ \text{A}, V_{CE} = 300\ \text{V}, L_S = 50\ \text{nH}$<br>$V_{GE} = \pm 15\ \text{V}, di/dt = 2200\ \text{A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$<br>$R_{Gon} = 6,8\ \Omega$  | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$                 | $E_{on}$      | 0,40<br>0,57<br>0,64    |      |             | mJ<br>mJ<br>mJ                                  |
| Abschaltverlustenergie pro Puls<br>Turn-off energy loss per pulse               | $I_C = 50\ \text{A}, V_{CE} = 300\ \text{V}, L_S = 50\ \text{nH}$<br>$V_{GE} = \pm 15\ \text{V}, du/dt = 4000\ \text{V}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$<br>$R_{Goff} = 6,8\ \Omega$ | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$                 | $E_{off}$     | 1,20<br>1,60<br>1,70    |      |             | mJ<br>mJ<br>mJ                                  |
| Kurzschlußverhalten<br>SC data  | $V_{GE} \leq 15\ \text{V}, V_{CC} = 360\ \text{V}$<br>$V_{CEmax} = V_{CES} - L_{sCE} \cdot di/dt$   | $t_p \leq 8\ \mu\text{s}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$<br>$t_p \leq 6\ \mu\text{s}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | $I_{SC}$      | 350<br>250              |      |             | A<br>A  |
| Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse<br>Thermal resistance, junction to case       | pro IGBT / per IGBT   |   | $R_{thJC}$    | 0,65                    | 0,73 |             | K/W   |
| Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper<br>Thermal resistance, case to heatsink | pro IGBT / per IGBT<br>$\lambda_{Paste} = 1\ \text{W}/(\text{m}\cdot\text{K}) / \lambda_{grease} = 1\ \text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$   |   | $R_{thCH}$    | 0,80                    |      |             | K/W   |

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| prepared by: SS | date of publication: 2012-01-12 |
| approved by: TR | revision: 3.0                   |

**Diode-Wechselrichter / Diode-inverter**  
**Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values**

|   |  |           |     |                      |
|---|--|-----------|-----|----------------------|
| Periodische Spitzensperrspannung<br>Repetitive peak reverse voltage | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$  | $V_{RRM}$ | 650 | V                    |
| Dauergleichstrom<br>Continuous DC forward current                   |  | $I_F$     | 50  | A                    |
| Periodischer Spitzenstrom<br>Repetitive peak forward current        | $t_p = 1 \text{ ms}$   | $I_{FRM}$ | 100 | A                    |
| Grenzlastintegral<br>$I^2t$ - value                                 | $V_R = 0 \text{ V}, t_p = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$<br>$V_R = 0 \text{ V}, t_p = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | $I^2t$    | 370 | $\text{A}^2\text{s}$ |
|   |  |           | 330 | $\text{A}^2\text{s}$ |

**Charakteristische Werte / Characteristic Values**

|   |   |                                | min.      | typ. | max. |               |
|---|---|--------------------------------|-----------|------|------|---------------|
| Durchlassspannung<br>Forward voltage  | $I_F = 50 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$  | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$  |           | 1,55 | 2,00 | V             |
|   | $I_F = 50 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$  | $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ | $V_F$     | 1,50 |      | V             |
|   | $I_F = 50 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$  | $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ |           | 1,45 |      | V             |
| Rückstromspitze<br>Peak reverse recovery current                                | $I_F = 50 \text{ A}, -di_F/dt = 2200 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$<br>$V_R = 300 \text{ V}$<br>$V_{GE} = -15 \text{ V}$           | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$  |           | 50,0 |      | A             |
|   |   | $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ | $I_{RM}$  | 60,0 |      | A             |
|   |   | $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ |           | 65,0 |      | A             |
| Sperrverzögerungsladung<br>Recovered charge                                     | $I_F = 50 \text{ A}, -di_F/dt = 2200 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$<br>$V_R = 300 \text{ V}$<br>$V_{GE} = -15 \text{ V}$           | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$  |           | 2,00 |      | $\mu\text{C}$ |
|   |   | $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ | $Q_r$     | 3,90 |      | $\mu\text{C}$ |
|   |   | $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ |           | 4,40 |      | $\mu\text{C}$ |
| Abschaltenergie pro Puls<br>Reverse recovery energy                             | $I_F = 50 \text{ A}, -di_F/dt = 2200 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$<br>$V_R = 300 \text{ V}$<br>$V_{GE} = -15 \text{ V}$           | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$  |           | 0,50 |      | mJ            |
|   |   | $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ | $E_{rec}$ | 1,00 |      | mJ            |
|   |   | $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ |           | 1,15 |      | mJ            |
| Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse<br>Thermal resistance, junction to case       | pro Diode / per diode   | $R_{thJC}$                     |           | 1,00 | 1,10 | K/W           |
| Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper<br>Thermal resistance, case to heatsink | pro Diode / per diode<br>$\lambda_{\text{Paste}} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K}) / \lambda_{\text{grease}} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ | $R_{thCH}$                     |           | 0,85 |      | K/W           |

**NTC-Widerstand / NTC-thermistor**

**Charakteristische Werte / Characteristic Values**

|  |  |              | min. | typ. | max. |            |
|--|--|--------------|------|------|------|------------|
| Nennwiderstand<br>Rated resistance       | $T_C = 25^{\circ}\text{C}$                                     | $R_{25}$     |      | 5,00 |      | k $\Omega$ |
| Abweichung von R100<br>Deviation of R100 | $T_C = 100^{\circ}\text{C}, R_{100} = 493 \Omega$              | $\Delta R/R$ | -5   |      | 5    | %          |
| Verlustleistung<br>Power dissipation     | $T_C = 25^{\circ}\text{C}$                                     | $P_{25}$     |      |      | 20,0 | mW         |
| B-Wert<br>B-value                        | $R_2 = R_{25} \exp [B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$  | $B_{25/50}$  |      | 3375 |      | K          |
| B-Wert<br>B-value                        | $R_2 = R_{25} \exp [B_{25/80}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$  | $B_{25/80}$  |      | 3411 |      | K          |
| B-Wert<br>B-value                        | $R_2 = R_{25} \exp [B_{25/100}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$ | $B_{25/100}$ |      | 3433 |      | K          |

Angaben gemäß gültiger Application Note.  
Specification according to the valid application note.

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| prepared by: SS | date of publication: 2012-01-12 |
| approved by: TR | revision: 3.0                   |

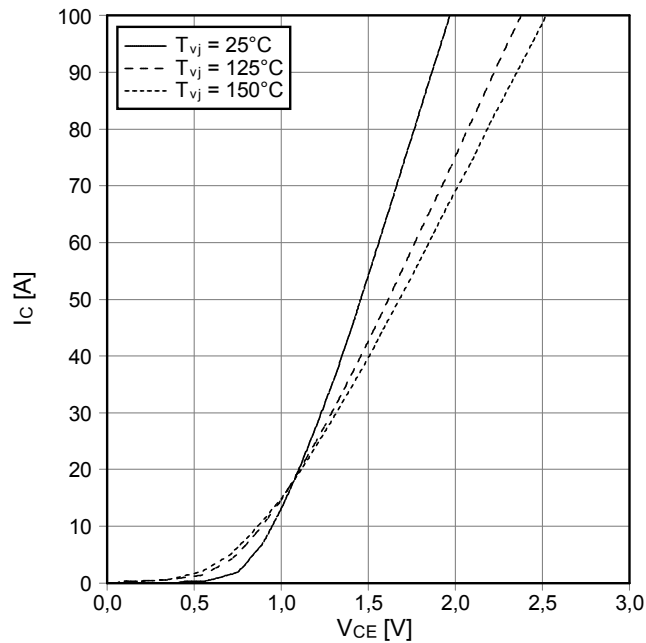


**Modul / Module**

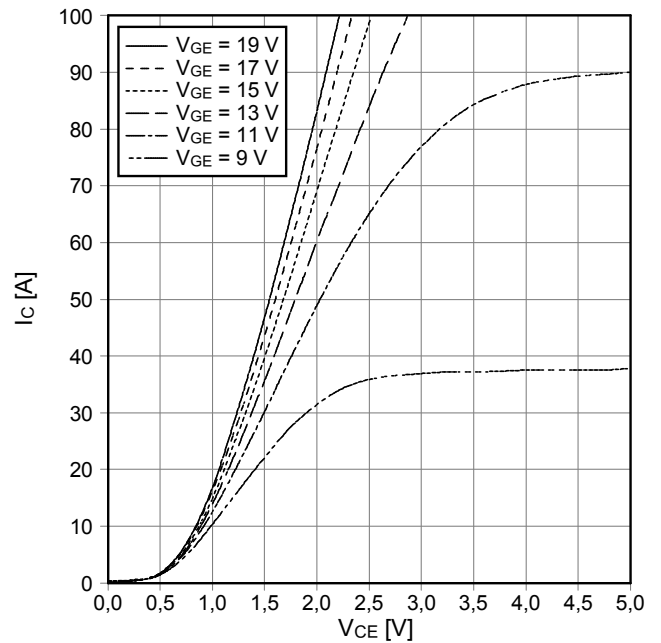
|  |   |                      |                                      |      |        |
|--|---|----------------------|--------------------------------------|------|--------|
| Isolations-Prüfspannung<br>Isolation test voltage                                      | RMS, f = 50 Hz, t = 1 min.  | V <sub>ISOL</sub>    | 2,5                                  |      | kV     |
| Innere Isolation<br>Internal isolation   |   |                      | impr. Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> |      |        |
| Kriechstrecke<br>Creepage distance   | Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink<br>Kontakt - Kontakt / terminal to terminal |                      | 11,5<br>6,3                          |      | mm     |
| Luftstrecke<br>Clearance   | Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink<br>Kontakt - Kontakt / terminal to terminal |                      | 10,0<br>5,0                          |      | mm     |
| Vergleichszahl der Kriechwegbildung<br>Comperative tracking index                      |   | CTI                  | > 200                                |      |        |
|  |   |                      | min.                                 | typ. | max.   |
| Modulstreuintuktivität<br>Stray inductance module                                      |   | L <sub>SCE</sub>     |                                      | 25   | nH     |
| Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip<br>Module lead resistance, terminals - chip | T <sub>C</sub> = 25°C, pro Schalter / per switch  | R <sub>CC'+EE'</sub> |                                      | 3,50 | mΩ     |
| Höchstzulässige Sperschichttemperatur<br>Maximum junction temperature                  | Wechselrichter, Brems-Chopper / Inverter, Brake-Chopper                                 | T <sub>vj max</sub>  |                                      |      | 175 °C |
| Temperatur im Schaltbetrieb<br>Temperature under switching conditions                  | Wechselrichter, Brems-Chopper / Inverter, Brake-Chopper                                 | T <sub>vj op</sub>   | -40                                  |      | 150 °C |
| Lagertemperatur<br>Storage temperature   |   | T <sub>stg</sub>     | -40                                  |      | 125 °C |
| Anpresskraft für mech. Bef. pro Feder<br>mounting force per clamp                      |   | F                    | 20                                   | -    | 50 N   |
| Gewicht<br>Weight  |   | G                    |                                      | 24   | g      |

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| prepared by: SS | date of publication: 2012-01-12 |
| approved by: TR | revision: 3.0                   |

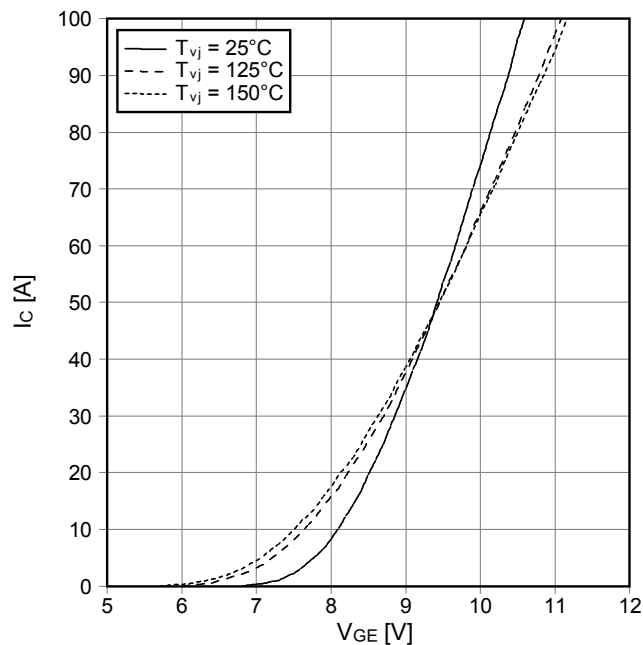
**Ausgangskennlinie IGBT-Wechselr. (typisch)**  
output characteristic IGBT-inverter (typical)  
 $I_c = f(V_{CE})$   
 $V_{GE} = 15\text{ V}$



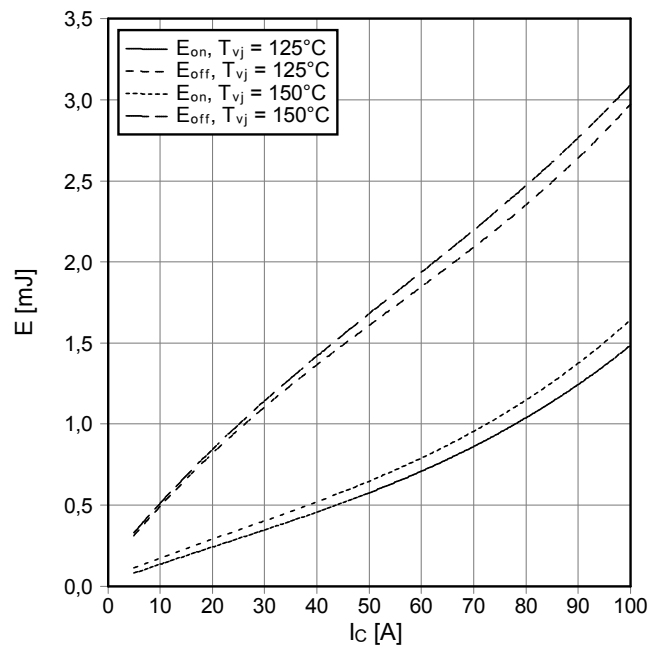
**Ausgangskennlinienfeld IGBT-Wechselr. (typisch)**  
output characteristic IGBT-inverter (typical)  
 $I_c = f(V_{CE})$   
 $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$



**Übertragungscharakteristik IGBT-Wechselr. (typisch)**  
transfer characteristic IGBT-inverter (typical)  
 $I_c = f(V_{GE})$   
 $V_{CE} = 20\text{ V}$

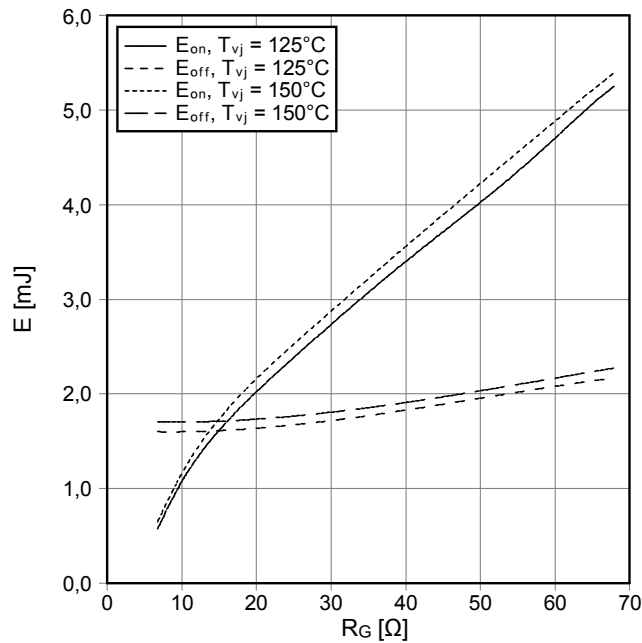


**Schaltverluste IGBT-Wechselr. (typisch)**  
switching losses IGBT-inverter (typical)  
 $E_{on} = f(I_c)$ ,  $E_{off} = f(I_c)$   
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ ,  $R_{Gon} = 6.8\ \Omega$ ,  $R_{Goff} = 6.8\ \Omega$ ,  $V_{CE} = 300\text{ V}$

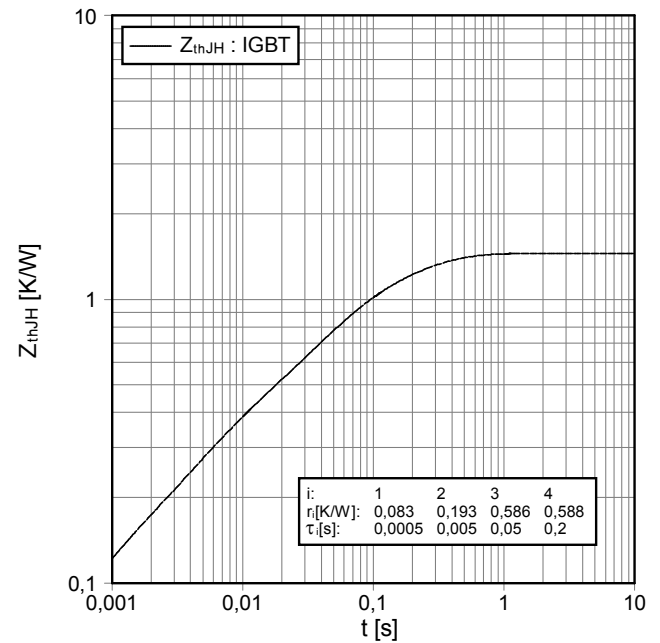




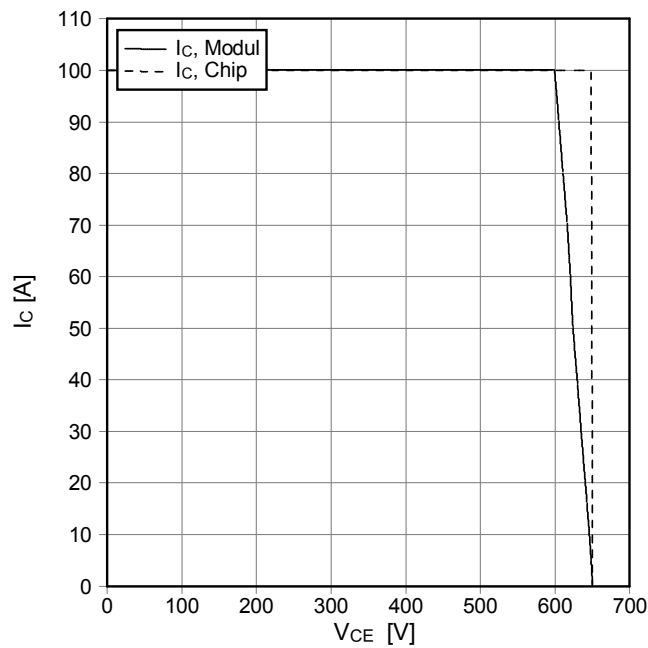
**Schaltverluste IGBT-Wechselr. (typisch)**  
switching losses IGBT-inverter (typical)  
 $E_{on} = f(R_G)$ ,  $E_{off} = f(R_G)$   
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ ,  $I_C = 50\text{ A}$ ,  $V_{CE} = 300\text{ V}$



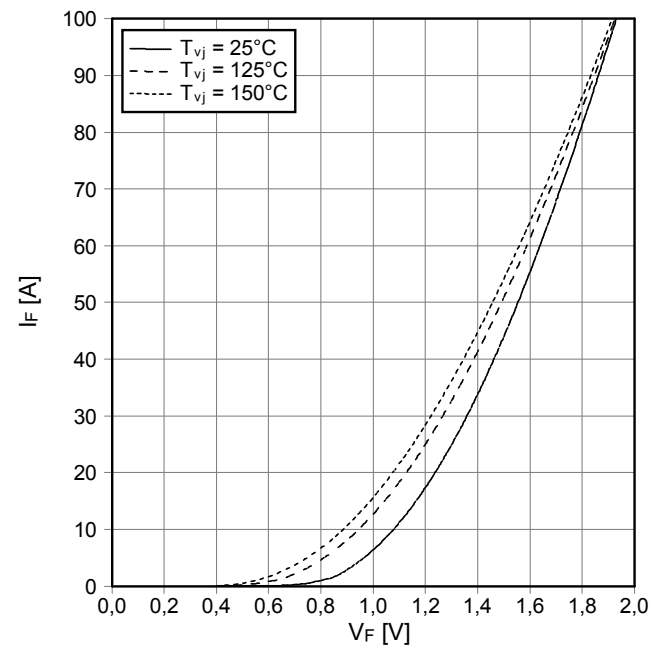
**Transienter Wärmewiderstand IGBT-Wechselr.**  
transient thermal impedance IGBT-inverter  
 $Z_{thJH} = f(t)$



**Sicherer Rückwärts-Arbeitsbereich IGBT-Wr. (RBSOA)**  
reverse bias safe operating area IGBT-inv. (RBSOA)  
 $I_C = f(V_{CE})$   
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ ,  $R_{Goff} = 6.8\ \Omega$ ,  $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$



**Durchlasskennlinie der Diode-Wechselr. (typisch)**  
forward characteristic of diode-inverter (typical)  
 $I_F = f(V_F)$

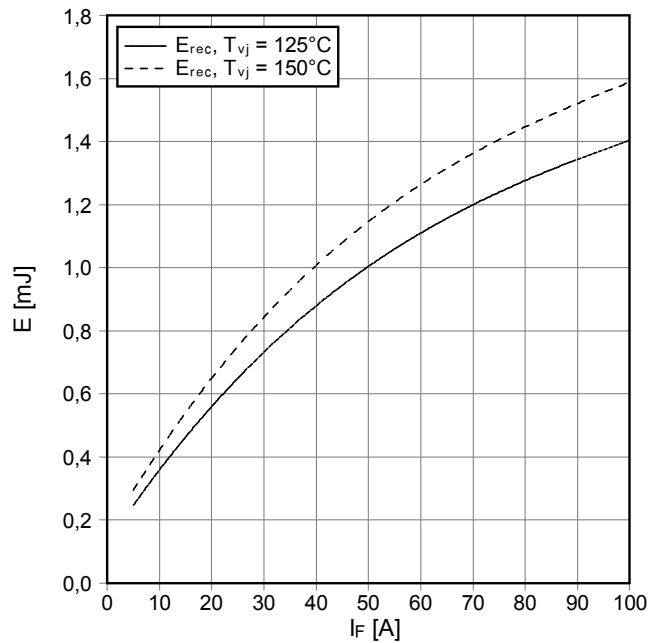


|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| prepared by: SS | date of publication: 2012-01-12 |
| approved by: TR | revision: 3.0                   |



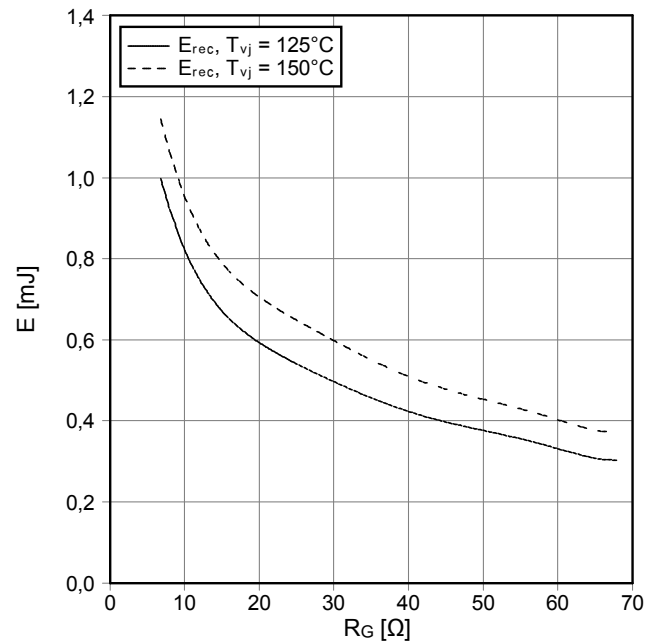
**Schaltverluste Diode-Wechselr. (typisch)**  
**switching losses diode-inverter (typical)**

$E_{rec} = f(I_F)$   
 $R_{Gon} = 6.8 \Omega, V_{CE} = 300 V$



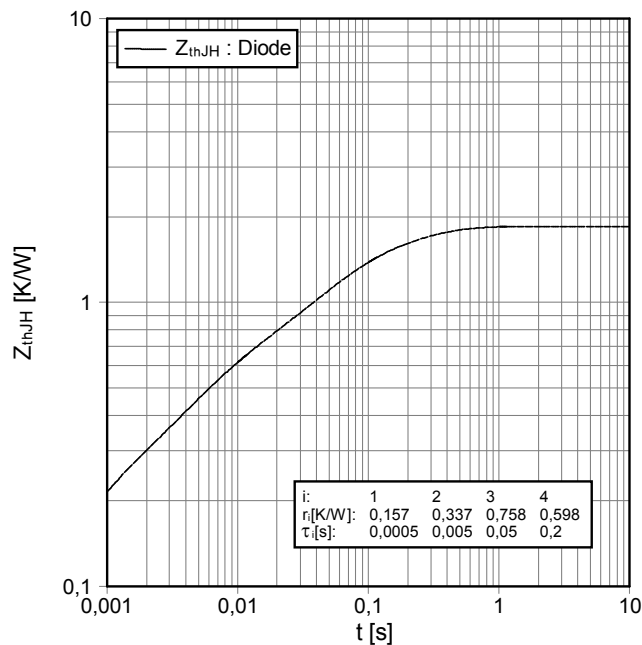
**Schaltverluste Diode-Wechselr. (typisch)**  
**switching losses diode-inverter (typical)**

$E_{rec} = f(R_G)$   
 $I_F = 50 A, V_{CE} = 300 V$



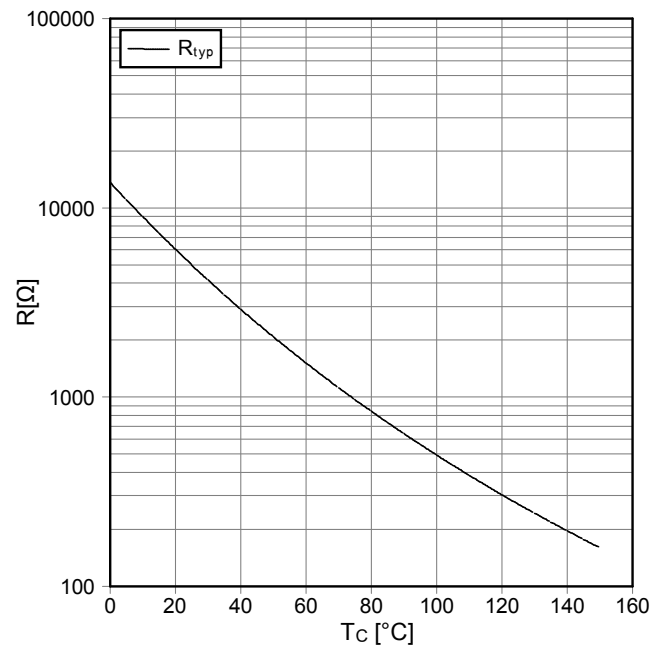
**Transienter Wärmewiderstand Diode-Wechselr.**  
**transient thermal impedance diode-inverter**

$Z_{thJH} = f(t)$



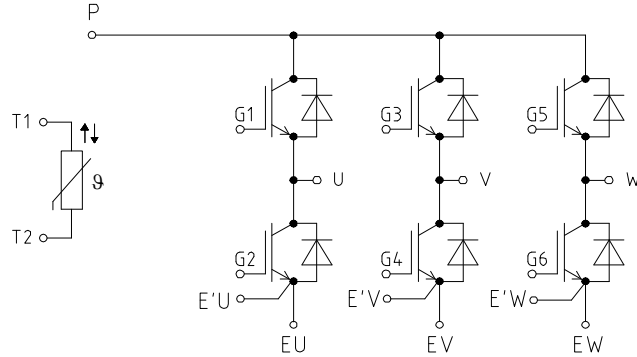
**NTC-Temperaturkennlinie (typisch)**  
**NTC-temperature characteristic (typical)**

$R = f(T)$

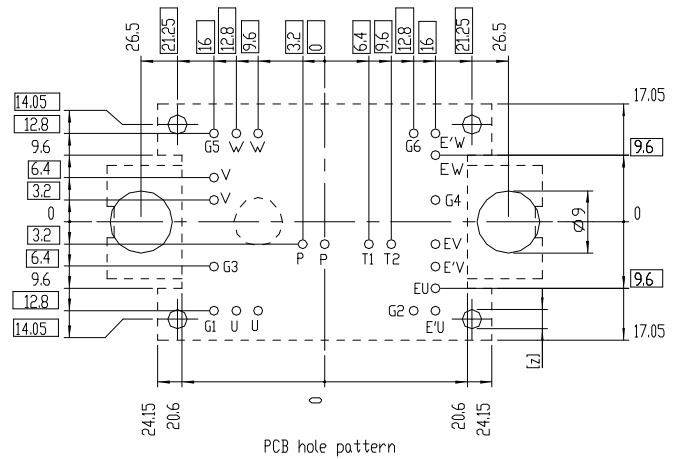
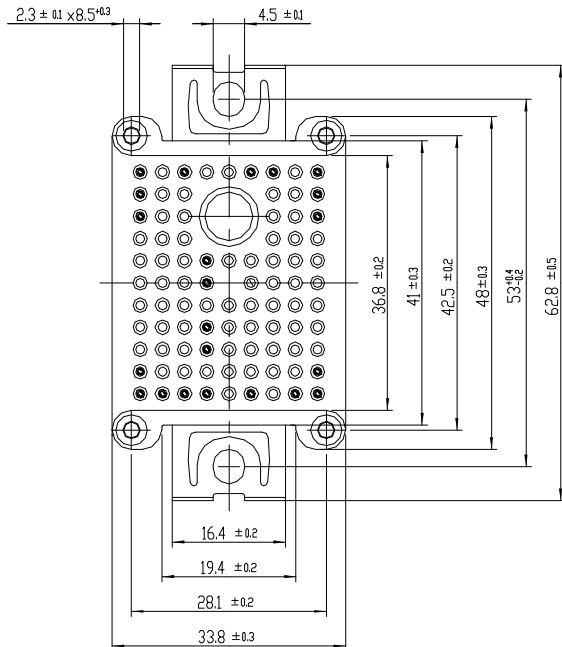
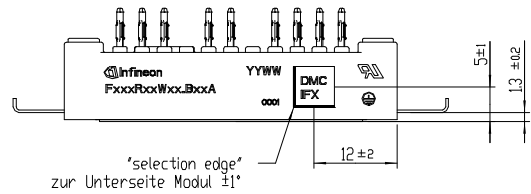
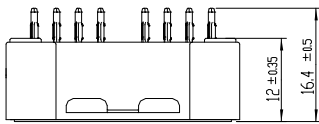


|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| prepared by: SS | date of publication: 2012-01-12 |
| approved by: TR | revision: 3.0                   |

Schaltplan / circuit diagram



Gehäuseabmessungen / package outlines



- Pin-Grid 3.2 mm
- Tolerance of PCB hole pattern  $\pm 0.1$  26x
- Hole specification for contacts see application note Easy PressFIT
- Diameters of drill  $\varnothing$  1.15 mm and copper thickness in hole 25 - 50  $\mu$ m
- [z] recommended diameter of PCB positioning guiding holes  $\varnothing$  2.8 mm

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| prepared by: SS | date of publication: 2012-01-12 |
| approved by: TR | revision: 3.0                   |





**Nutzungsbedingungen**

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses Produktes für Ihre Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung (siehe [www.infineon.com](http://www.infineon.com), Vertrieb&Kontakt). Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle

- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

**Terms & Conditions of usage**

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see [www.infineon.com](http://www.infineon.com), sales&contact). For those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or live endangering or life support applications, please notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend

- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| prepared by: SS | date of publication: 2012-01-12 |
| approved by: TR | revision: 3.0                   |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9